

SOT23 NPN硅平面
中功率晶体管

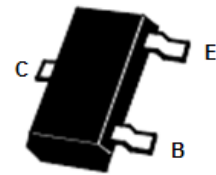
BC817

ISSUE 5 - 2001年3月



PARTMARKING详情

BC81716 - 6AZ
BC81725 - 6BZ
BC81740 - 6CZ



SOT23

互补式

?? BC807

绝对最大额定值。

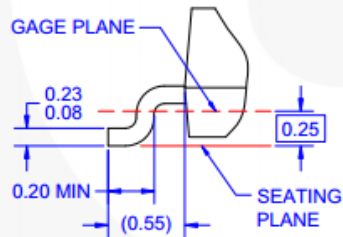
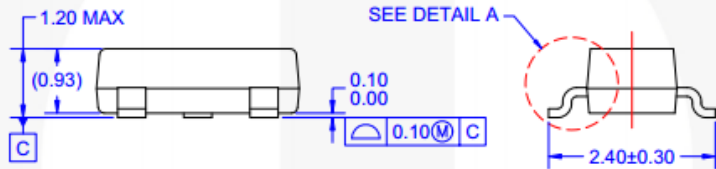
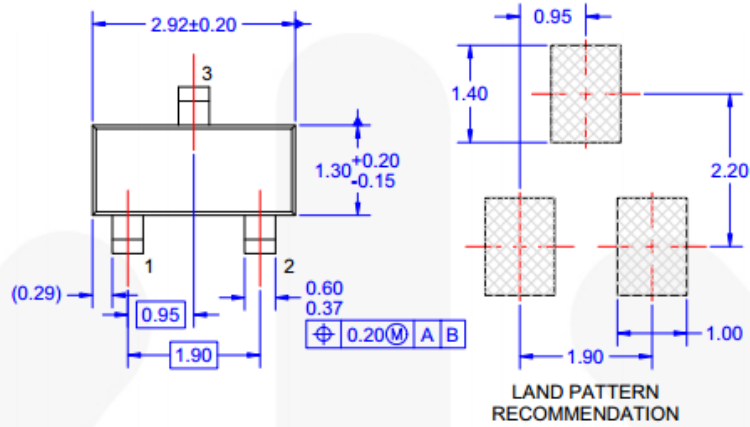
参数	符号	价值	单位
集电极 - 基极电压	V_{CE0}	50	V
集电极 - 发射极电压	$V_{CE(sat)}$	45	V
发射极 - 基极电压	V_{EB0}	5	V
峰值脉冲电流	I_{CM}	1	A
连续集电极电流	I_C	500	mA
基极电流	I_B	100	mA
峰值电流基地	I_{EM}	200	mA
在T功耗	P_{tot}	330	mW
工作和存储温度范围	$T_{j,T 存储}$	-55到+150	°C

电气特性（在T

$A_{MB} = 25^{\circ}C$ 除非另有说明）。

参数	符号	分钟。	典型值。	MAX。	单位条件。
集电极截止 当前	I_{CE0}			0.1 5	$^{\circ}A$ $^{\circ}A$ $V_{CE} = 20V, I_B = 0$ $V_{CE} = 20V, I_B = 0, T_{AMB} = 150^{\circ}C$
发射极截止电流	I_{EB0}			10	$^{\circ}A$ $V_{EB} = 5V, I_B = 0$
集电极 - 发射极 饱和电压	$V_{CE(sat)}$			700	mV $I_C = 500$ 毫安, $I_B = 50$ mA*
基射 饱和电压	$V_{BE(sat)}$			1.2	V $I_C = 500$ 毫安, $V_{CE} = 1V^*$
静态正向电流 传输比	h_{FE}				
	BC81716	100	250		$I_C = 100$ mA时 $V_{CE} = 1V^*$
	BC81725	160	400		$I_C = 100$ mA时 $V_{CE} = 1V^*$
	BC81740	250	600		$I_C = 100$ mA时 $V_{CE} = 1V^*$
所有乐队		40			$I_C = 500$ 毫安, $V_{CE} = 1V^*$
跃迁频率	f_T		200		兆赫 $I_C = 10$ 毫安, $V_{CE} = 5V$ $f = 35$ MHz
输出电容	C_{out}		5.0		pF $V_{CE} = 10V, F = 1$ MHz的

*脉冲条件下进行测定。



NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

- A) REFERENCE JEDEC REGISTRATION TO-236, VARIATION AB, ISSUE H.
- B) ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
- C) DIMENSIONS ARE INCLUSIVE OF BURRS, MOLD FLASH AND TIE BAR EXTRUSIONS.
- D) DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M - 1994.
- E) DRAWING FILE NAME: MA03DREV10